

引用信息: Deng Zong-Wu; Guo Wei-Min; Liu Huan-Ming; Cao Li-Li. Acta Phys. -Chim. Sin., 1999, 15(06): 528-532 [邓宗武; 郭伟民; 刘焕明; 曹立礼. 物理化学学报, 1999, 15(06): 528-532]

[本期目录](#) | [在线预览](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

研究论文

GaAs(100)解理面的能带弯曲

邓宗武; 郭伟民; 刘焕明; 曹立礼

清华大学化学系, 北京 100084; 香港中文大学化学系; 香港中文大学物理系

摘要:

关键词: GaAs 能带弯曲 动态过程 XPS

收稿日期 1998-09-30 修回日期 1998-12-23 网络版发布日期 1999-06-15

通讯作者: 曹立礼 Email:

本刊中的类似文章

1. 汤傲; 马信洲; 何辉忠; 张力; 林密旋; 曲东升; 丁庆勇; 孙立宁. 微圆盘电极技术测定表面化学微加工时的约束刻蚀剂浓度分布[J]. 物理化学学报, 2006, 22(04): 507-512
2. 童汝亭; 刘伟; 李果华; 李国昌. ZnSe/GaAs/电解液光电化学特性的研究[J]. 物理化学学报, 1997, 13(04): 358-361
3. 沈少来; 唐景昌; 曹松; 汪雷. Cl/GaAs(111)表面近边X射线吸收精细结构的多重散射研究[J]. 物理化学学报, 2003, 19(11): 1054-1058
4. 王卫江; 王江涛; 金承和; 陆寿蕴. *n*型砷化镓微区光电化学腐蚀过程[J]. 物理化学学报, 1993, 9(03): 386-391

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(1499KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [GaAs](#)

▶ [能带弯曲](#)

▶ [动态过程](#)

▶ [XPS](#)

本文作者相关文章

▶ [邓宗武](#)

▶ [郭伟民](#)

▶ [刘焕明](#)

▶ [曹立礼](#)